

# 単結晶ロックンクカーブ測定、OFF角、d値解析

## 1.概要もしくは特長

単結晶材料の結晶性評価

## 2.装置仕様等

Ge(022)4結晶モノクロメーター( $\Delta\lambda$ :0.01%)+4軸( $2\theta, \Omega, \varphi, \chi$ )+3軸リニアステージ装備  
 回折計によるロックンクカーブ半値幅、OFF角、d値の精密測定、試料内分布測定も可  
 測定精度:1/1000° ( $\Omega$ スキャン,  $2\theta/\Omega$ スキャン)

## 3.試料情報

- 測定可能試料寸法:170 mmφ x 5 mmt以下
- 測定可能結晶方位(実績):  
 Si : (100), (111), (311)  
 サファイア( $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>): (0001)  
 β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: (100), (11-3), (010), (001)  
 他、多数

## 4.測定事例

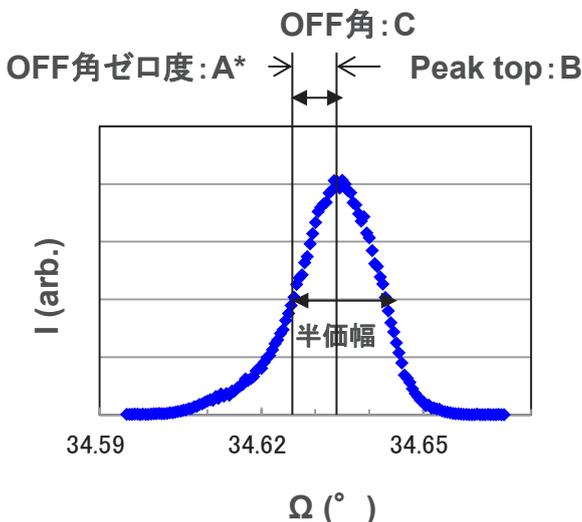


図1  $\Omega$ (ロックンクカーブ)スキャンの例  
Si (100)

$$C = A - B$$

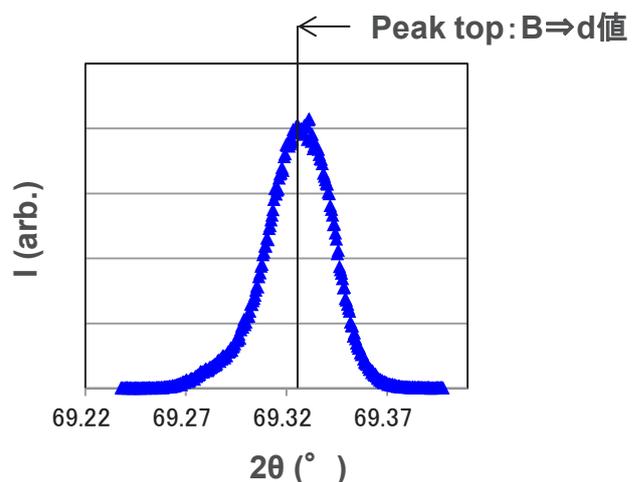


図2  $2\theta/\Omega$ スキャンの例  
Si (100)

$$d = \lambda / 2 \sin \theta$$

\*Aの位置は説明のためにシフトしてあり、実際の位置と異なります。